

## HM5421B/C

## 双节锂电池保护 IC

### 一、 概述

HM5421系列IC，内置高精度电压检测电路和延时电路，是用于2节串联锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。

此系列IC适合于对2节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

### 二、 特点

HM5421全系列IC具备如下特点：

(1) 高精度电压检测

➤ 过充电检测电压 $V_{CUn}$ ( $n=1, 2$ )	4.10V~4.50V	精度 $\pm 25\text{mV}$
➤ 过充电释放电压 $V_{CRn}$ ( $n=1, 2$ )	3.90V~4.30V	精度 $\pm 50\text{mV}$
➤ 过放电检测电压 $V_{DLn}$ ( $n=1, 2$ )	2.00V~3.00V	精度 $\pm 80\text{mV}$
➤ 过放电释放电压 $V_{DRn}$ ( $n=1, 2$ )	2.30V~3.40V	精度 $\pm 100\text{mV}$
➤ 放电过流检测电压	(可选择)	
➤ 充电过流检测电压	(可选择)	精度 $\pm 30\text{mV}$
➤ 负载短路检测电压	1.0V (固定)	精度 $\pm 0.4\text{V}$

(2) 各延迟时间由内部电路设置 (不需外接电容)

➤ 过充电检测延迟时间	典型值1000ms
➤ 过放电检测延迟时间	典型值110ms
➤ 放电过流检测延迟时间	典型值10ms
➤ 充电过流检测延迟时间	典型值7ms
➤ 负载短路检测延迟时间	典型值250μs

(3) 低耗电流

➤ 工作模式	典型值5.0μA，最大值9.0μA ( $VDD=7.8\text{V}$ )
➤ 休眠模式	最大值0.1μA ( $VDD=4.0\text{V}$ )

(4) 连接充电器的端子采用高耐压设计 (CS端子和OC端子，绝对最大额定值是33V)

(5) 向0V电池充电功能：可以选择“允许”或“禁止”

(6) 宽工作温度范围：-40°C~+85°C

(7) 小型封装：SOT-23-6

(8) HM5421系列是无卤素绿色环保产品

### 三、 产品应用

- 2节串联锂离子可再充电电池组。
- 2节串联锂聚合物可再充电电池组。

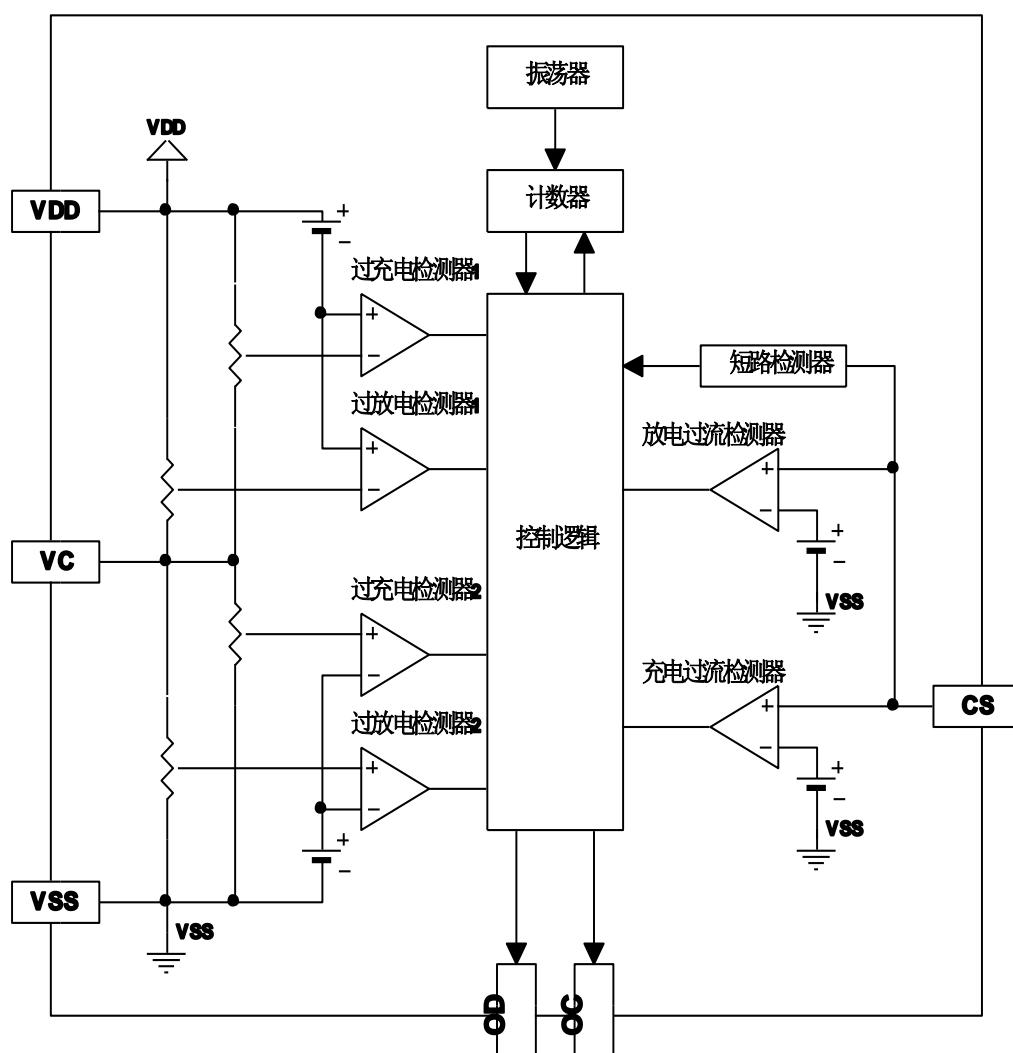
### 四、 产品目录

参数 型号	过充电检测 电压	过充电释放 电压	过放电检测 电压	过放电释 放电压	放电过流检 测电压	充电过流检 测电压	向0V电 池充 电功 能
	$V_{CUn}$	$V_{CRn}$	$V_{DLn}$	$V_{DRn}$	$V_{DIP}$	$V_{CIP}$	$V_{OCH}$
HM5421-B	4.35±0.025V	4.15±0.05V	2.30±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许
HM5421-C	4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.90±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许

## HM5421B/C

## 双节锂电池保护 IC

### 五、 方框图



### 六、 封装脚位及功能说明

封装外形图		序号	符号	说明
 <b>SOT-26</b>		1	OD	放电控制用MOSFET门极连接端子
		2	OC	充电控制用MOSFET门极连接端子
		3	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子
		4	VC	电池1负极、电池2正极连接端子
		5	VDD	正电源输入端子，电池1正极连接端子
		6	VSS	接地端，负电源输入端子，电池2负极连接端子

## HM5421B/C

## 双节锂电池保护 IC

### 七、 绝对最大额定值

(VSS=0V, Ta=25°C , 除非特别说明)

项目	符号	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	V <sub>DD</sub>	VSS-0.3~VSS+10	V
OC 输出端子电压	V <sub>OC</sub>	VDD-33~VDD+0.3	V
OD 输出端子电压	V <sub>OD</sub>	VSS-0.3~VDD+0.3	V
CS 输入端子电压	V <sub>CS</sub>	VDD-33~VDD+0.3	V
工作温度范围	T <sub>OP</sub>	-40~+85	°C
储存温度范围	T <sub>ST</sub>	-40~+125	°C
容许功耗	P <sub>D</sub>	250	mW

### 八、 电气特性

(VSS=0V, Ta=25°C , 除非特别说明)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>输入电压</b>						
VDD-VSS 工作电压	V <sub>DSOP1</sub>	—	1.5	—	10	V
VDD-CS 工作电压	V <sub>DSOP2</sub>	—	1.5	—	33	V
<b>耗电流</b>						
工作电流	I <sub>DD</sub>	VDD=7.8V	—	5.0	9.0	uA
休眠电流	I <sub>PD</sub>	VDD=4.0V	—	—	0.1	uA
<b>检测电压</b>						
过充电检测电压n (*1)	V <sub>CUn</sub>	4.1~4.5V, 可调整	VCUn -0.025	VCUn	VCUn +0.025	V
过充电释放电压n (*1)	V <sub>CRn</sub>	3.9~4.3V, 可调整	VCRn -0.05	VCRn	VCRn +0.05	V
过放电检测电压n (*1)	V <sub>DLn</sub>	2.0~3.0V, 可调整	VDLn -0.08	VDLn	VDLn +0.08	V
过放电释放电压n (*1)	V <sub>DRn</sub>	2.3~3.4V, 可调整	VDRn -0.10	VDRn	VDRn +0.10	V
放电过流检测电压	V <sub>DIP</sub>		VDIP -30	VDIP	VDIP +30	mV
负载短路检测电压	V <sub>SIP</sub>	VDD-VSS=7.0V	0.6	1.0	1.4	V
充电过流检测电压	V <sub>CIP</sub>		VCIP -30	VCIP	VCIP +30	mV
<b>延迟时间</b>						
过充电检测延迟时间	T <sub>OC</sub>		700	1000	1300	ms
过放电检测延迟时间	T <sub>OD</sub>		70	110	150	ms
放电过流检测延迟时间	T <sub>DIP</sub>		6	10	14	ms
充电过流检测延迟时间	T <sub>CIP</sub>		4	7	10	ms
负载短路检测延迟时间	T <sub>SIP</sub>		150	250	400	μs
<b>控制端子输出电压</b>						
OD端子输出高电压	V <sub>DH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02		V

## HM5421B/C

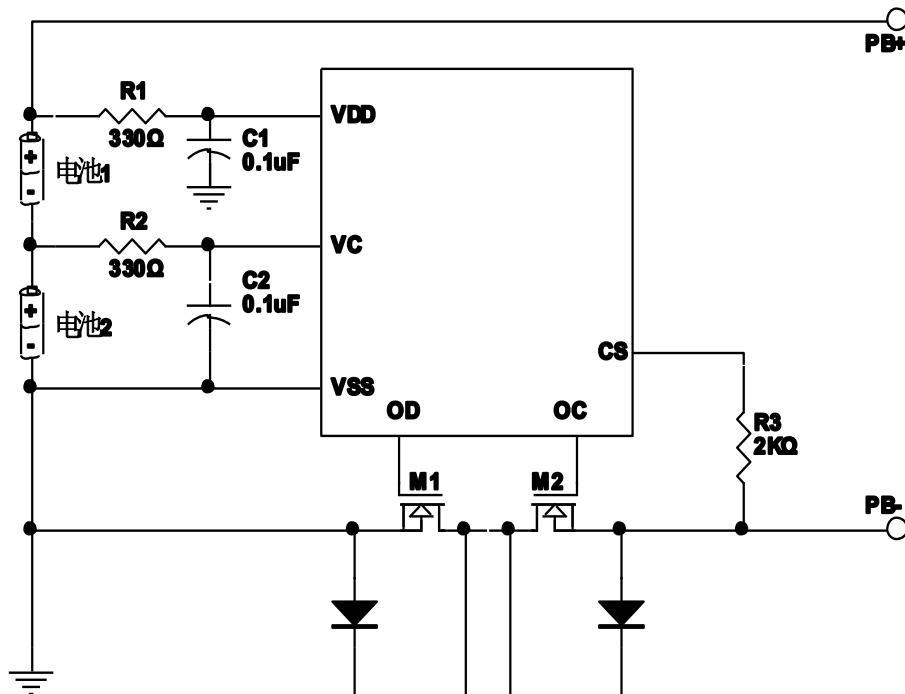
## 双节锂电池保护 IC

OD端子输出低电压	V <sub>DL</sub>			0.2	0.5	V
OC端子输出高电压	V <sub>CH</sub>		VDD-0.1	VDD-0.02		V
OC端子输出低电压	V <sub>CL</sub>			0.2	0.5	V
向0V电池充电的功能(允许或禁止)						
充电器起始电压(允许向0V电池充电功能)	V <sub>OCH</sub>	允许向0V电池充电功能	1.2	-	-	V
电池电压(禁止向0V电池充电功能)	V <sub>OIN</sub>	禁止向0V电池充电功能	-	-	0.5	V

4

5

### 九、应用电路图



标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定VDD、加强ESD	100Ω	330Ω	470Ω	*1
R2	电阻	限流、稳定VC、加强ESD	100Ω	330Ω	470Ω	*1
R3	电阻	限流	1 kΩ	2kΩ	4kΩ	*2
C1	电容	滤波, 稳定VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
C2	电容	滤波, 稳定VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
M1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
M2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

\*1、R1或R2连接过大电阻，由于芯片消耗的电流会在R1或R2上产生压降，影响检测电压精度。当充电器反接时，电流从充电器流向IC，若R1或R2过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

\*2、R3连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

## HM5421B/C

## 双节锂电池保护 IC

\*3、C1和C2有稳定VDD电压的作用，请不要连接0.01μF以下的电容。

\*4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

\*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET有可能被损坏。

### 十、 工作说明

#### ➤ 正常工作状态

此IC持续检测连接在VDD与VC端子之间电池1的电压、连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，以及CS与VSS端子之间的电压差，来控制充电和放电。当电池1和电池2的电压都在过放电检测电压( $V_{DLn}$ )以上并在过充电检测电压( $V_{CuN}$ )以下，且CS端子电压在充电过流检测电压( $V_{CIP}$ )以上并在放电过流检测电压( $V_{DIP}$ )以下时，IC的OC和OD端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，充电和放电都可以自由进行。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接CS端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

#### ➤ 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，超过过充电检测电压( $V_{CuN}$ )，并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间( $T_{OC}$ )时，IC的OC端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET(OC端子)，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以释放，OC端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

- (1) 断开充电器，由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电释放电压( $V_{CRn}$ )以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。
- (2) 断开充电器，连接负载，当电池1和电池2的电压都降低到过充电检测电压( $V_{CuN}$ )以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：

①进入过充电状态的电池，如果仍然连接着充电器，即使电池1和电池2的电压都低于过充电释放电压( $V_{CRn}$ )，过充电状态也不能释放。断开充电器，CS端子电压上升到充电过流检测电压( $V_{CIP}$ )以上时，过充电状态才能释放。

②当电池1或电池2的电压超过过充电检测电压( $V_{CuN}$ )，断开充电器并连接负载，如果电池1或电池2的电压仍不能降低到过充电检测电压( $V_{CuN}$ )以下，此时放电电流通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过，当电池1和电池2的电压都降低到过充电检测电压( $V_{CuN}$ )以下时，OC端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

③当电池1或电池2的电压超过过充电检测电压( $V_{CuN}$ )，但在过充电检测延迟时间( $T_{OC}$ )之内，电池1和电池2的电压又降低到过充电检测电压( $V_{CuN}$ )以下，则此时不进入过充电保护状态。

④OC端子高电平是上拉到VDD端子，OC端子低电平是下拉到CS端子。

#### ➤ 过放电状态及休眠状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，降低到过放电检测电压( $V_{DLn}$ )以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间( $T_{OD}$ )时，IC的OD端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

## HM5421B/C

## 双节锂电池保护 IC

当关闭放电控制用MOSFET后，CS由IC内部电阻上拉到VDD，使IC耗电流减小到休眠时的耗电流值(<0.1uA)，这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态在以下两种情况下可以释放，OD端子输出电压由低电平变为高电平，使放电控制用MOSFET导通。

(1) 连接充电器，若CS端子电压低于充电过流检测电压( $V_{CIP}$ )，当电池1和电池2的电压都高于过放电检测电压( $V_{DLn}$ )时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

(2) 连接充电器，若CS端子电压高于充电过流检测电压( $V_{CIP}$ )，当电池1和电池2的电压都高于过放电释放电压( $V_{DRn}$ )时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：

①当电池1或电池2的电压低于过放电检测电压( $V_{DLn}$ )，但在过放电检测延迟时间( $T_{OD}$ )之内，电池1和电池2的电压又回升到过放电检测电压( $V_{DLn}$ )以上，则此时不进入过放电保护状态。

②OD端子高电平是上拉到VDD端子，OD端子低电平是下拉到VSS端子。

### ➤ 放电过流状态（放电过流检测功能和负载短路检测功能）

正常工作状态下的电池，IC通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检测电压( $V_{DIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间( $T_{DIP}$ )，则OD端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压( $V_{SIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间( $T_{SIP}$ )，则OD端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET(OD端子)，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于 $450\text{k}\Omega$ (typ.)时。放电过流状态和负载短路状态的将被释放。

另外，即使连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗小于 $450\text{k}\Omega$ (typ.)时，当连接上充电器，CS端子电压降低到放电过流保护电压( $V_{DIP}$ )以下，也会释放放电过流状态或负载短路状态，回到正常工作状态。

### ➤ 充电过流状态

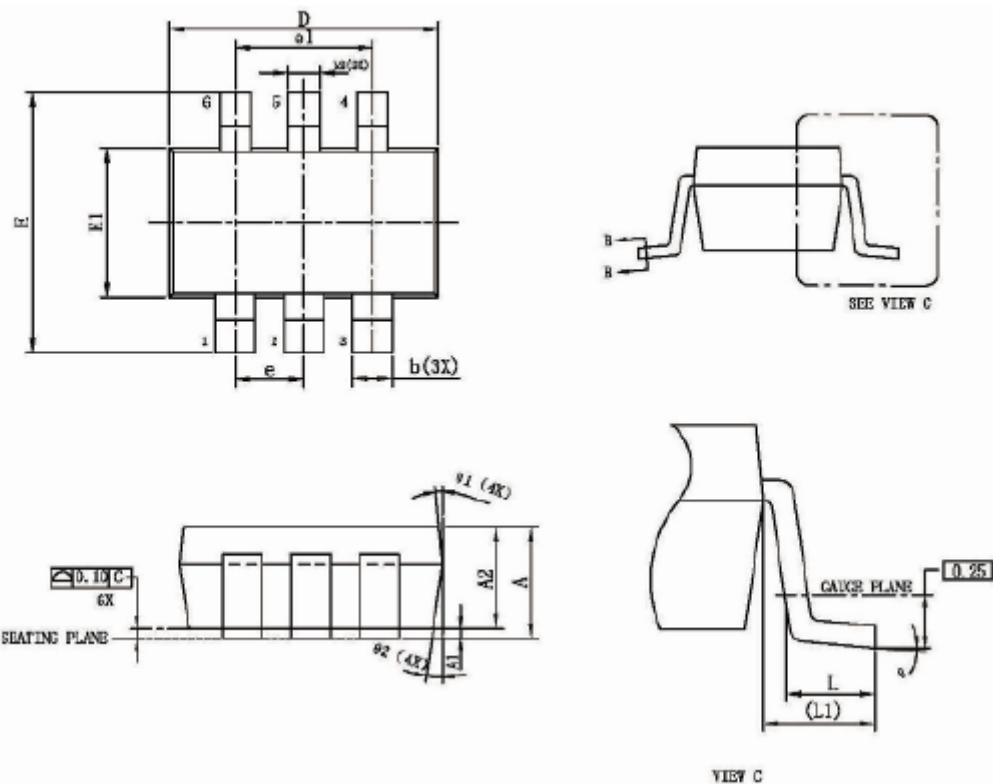
正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果CS端子电压低于充电过流检测电压( $V_{CIP}$ )，并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间( $T_{CIP}$ )，则OC端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET(OC端子)，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使CS端子电压高于充电过流检测电压( $V_{CIP}$ )时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

# HM421B/C

## 双节锂电池保护 IC

### 十一、封装信息



SYM BOL	ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
A	-	1.30	1.40
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.20	1.30
b	0.40	-	0.55
b1	0.40	0.45	0.50
b2	0.25	-	0.40
c	0.08	-	0.20
c1	0.08	0.11	0.15
D	2.70	2.90	3.00
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.95 BSC		
e1	1.90 BSC		
L	0.35	0.45	0.55
L1	0.60 REF		
theta	0°	5°	10°
theta1	3°	5°	7°
theta2	6°	8°	10°

